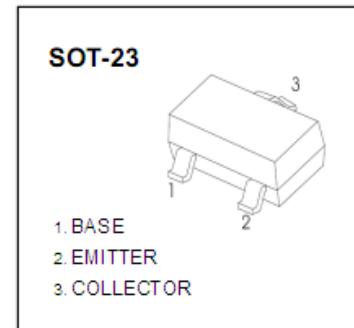




SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors**BC807-16/BC807-25/BC807-40(PNP)****特点/Features :**I_c大，电流增益大；**用途/Applications :**

用于一般功率放大电路及开关，与 BC817 互补。

**极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)**

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	V _{CBO}	-50	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	V _{CEO}	-45	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	V _{EBO}	-5	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	I _c	-0.5	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	P _c	0.3	W
结温/Junction Temperature	T _j	150	°C
储存温度/Storage Temperature	T _{stg}	-55~150	°C

电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	V _{BR(CBO)}	I _c =-10 μA, I _e =0	-50		V
集电极-发射极击穿电压	V _{BR(CEO)}	I _c =-10mA, I _b =0	-45		V
发射极-基极击穿电压	V _{BR(EBO)}	I _e =-1 μA, I _c =0	-5		V
集电极截止电流	I _{CBO}	V _{CB} =-45V, I _e =0		-0.1	μA
发射极截止电流	I _{EBO}	V _{EB} =-4V, I _c =0		-0.1	μA
集电极发射极穿透电流	I _{CEO}	V _{CE} =-40V, I _b =0		-0.2	μA
直流电流增益	h _{FE}	V _{CE} =-1V, I _c =-100mA	100	600	
集电极-发射极饱和压降	V _{CE(sat)}	I _c =-500mA, I _b =-50mA		-0.7	V
基极-发射极饱和压降	V _{BE(sat)}	I _c =-500mA, I _b =-50mA		-1.2	V
特征频率	f _T	V _{CE} =-5V, I _c =-10mA, f=100MHz	100		MHz
输出电容	C _{ob}	V _{CB} =-10V, I _e =0, f=1MHz		5	pF

h_{FE} 分档/Classification of h_{FE}

档位/Rank	16	25	40
范围/Range	100~250	160~400	250~600
印章/Marking	5A	5B	5C



SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors

典型特性曲线图/Typical Characteristics

